



特征

采用最新沟槽栅场截止型IGBT芯片

集成NTC温度传感器

高可靠性及热稳定性

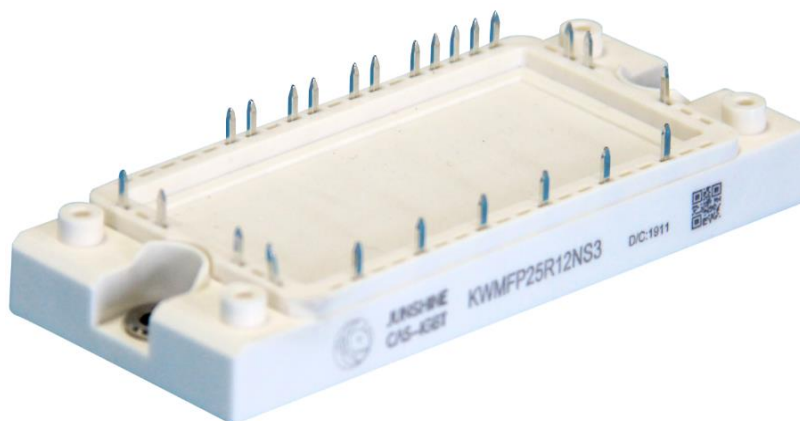
良好的参数一致性

100% RBSOA测试 ($2 \times I_C$)

低通态损耗 ($V_{CE}=2.0V$)

低关断损耗 ($E_{off}=1.22mJ$)

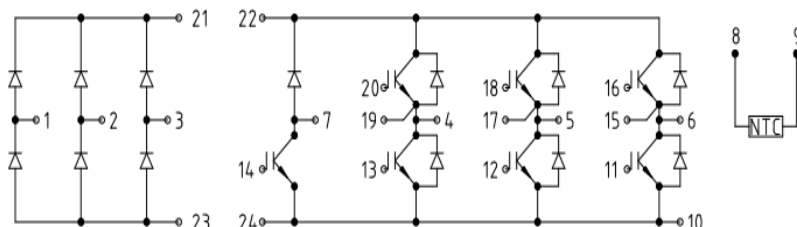
高短路耐量 ($>10\mu s$)



应用领域

电机传动

伺服驱动器 等



IGBT(逆变器)最大额定值 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ C$)

参数	符号	条件	额定值	单位
集电极-发射极耐压	V_{CES}		1200	V
栅极-发射极耐压	V_{GES}		± 20	
集电极电流	I_C	$T_C=25^\circ C$	50	A
		$T_C=100^\circ C$	25	
集电极重复峰值电流	I_{CRM}	$t_p=1ms$	50	A
耗散功率	P_D	$T_C=25^\circ C, T_{vj\max}=150^\circ C$	156	W
短路承受时间	t_{SC}	$V_{GE}=15V, V_{CC}=600V$ $T_j=150^\circ C$	>10	μs
工作结温	T_j		$-40 \sim 150$	$^\circ C$

IGBT(逆变器)电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态特性						
集电极-发射极击穿电压	$V_{(BR)CES}$	$V_{GE}=0V, I_C=1mA$	1200	-	-	V
导通压降	$V_{CE(sat)}$	$V_{GE}=15V, I_C=25A$ $T_j=25^{\circ}\text{C}$ $T_j=150^{\circ}\text{C}$	- -	2.0 2.6	- -	V
阈值电压	$V_{GE(th)}$	$I_C=1mA, V_{CE}=V_{GE}$	5.2	5.9	6.7	V
集电极-发射极漏电流	I_{CES}	$V_{CE}=1200V, V_{GE}=0V$	-	-	2.0	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{CE}=0V, V_{GE}=20V$	-	-	500	nA
输入电容	C_{iss}	$V_{CE}=25V$	-	1795	-	pF
输出电容	C_{oss}	$V_{GE}=0V$	-	125	-	
反馈电容	C_{rss}	$f=1MHz$	-	80	-	
栅电荷	Q_G	$V_{CC}=900V, I_C=25A, V_{GE}=15V$	-	100	-	nC
开关特性 (感性负载)						
开通延迟时间	$t_{d(on)}$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$ $V_{CC}=600V$ $I_C=25A$	-	70	-	ns
上升时间	t_r		-	103	-	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		-	110	-	
下降时间	t_f		-	226	-	
开通损耗	E_{on}	$V_{GE}=\pm 15V$ $R_G=47\Omega$	-	2.85	-	mJ
关断损耗	E_{off}		-	1.22	-	
开关损耗	E_{ts}		-	4.07	-	
开通延迟时间	$t_{d(on)}$	$T_j=150^{\circ}\text{C}$ $V_{CC}=600V$ $I_C=25A$	-	67	-	ns
上升时间	t_r		-	105	-	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		-	255	-	
下降时间	t_f		-	237	-	
开通损耗	E_{on}	$V_{GE}=\pm 15V$ $R_G=47\Omega$	-	3.00	-	mJ
关断损耗	E_{off}		-	1.67	-	
开关损耗	E_{ts}		-	4.67	-	
集电极短路电流	I_{SC}	$V_{GE}=15V, V_{CC}=600V,$ $T_j=150^{\circ}\text{C}$	-	93	-	A
壳到结的热阻	R_{thJC}	每个IGBT	-	0.80	-	K/W

二极管(逆变器)最大额定值 (未特殊说明时, $T_j=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	条件	额定值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		1200	V
连续正向直流电流	I_F	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	50	A
		$T_C=100^{\circ}\text{C}$	25	
正向重复峰值电流	I_{FRM}	$t_p=1\text{ms}$	50	A
电流时间积分	$I^2 t$	$t_p=10\text{ms}, T_C=100^{\circ}\text{C}$	85	A^2s
工作结温	T_j		-40~150	$^{\circ}\text{C}$

二极管(逆变器)电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
正向压降	V_F	$I_F=25\text{A}$	-	1.90	-	V
		$T_j=25^{\circ}\text{C}$	-	1.85	-	
		$T_j=150^{\circ}\text{C}$	-	-	-	
反向恢复时间	t_{rr}	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	-	135	-	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$V_R=600\text{V}, I_F=25\text{A}$	-	1.6	-	μC
反向恢复峰值电流	I_{rrm}	$-di/dt=600\text{A}/\mu\text{s}$	-	24.0	-	A
反向恢复时间	t_{rr}	$T_j=150^{\circ}\text{C}$	-	275	-	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$V_R=600\text{V}, I_F=25\text{A}$	-	3.6	-	μC
反向恢复峰值电流	I_{rrm}	$-di/dt=600\text{A}/\mu\text{s}$	-	32.0	-	A
壳到结的热阻	R_{thJC}	每个二极管	-	1.2	-	K/W

二极管(整流器)最大额定值 (未特殊说明时, $T_j=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	条件	额定值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}	$T_j=25^{\circ}\text{C}, I_R=0.1\text{mA}$	1600	V
正向平均电流	$I_{F(AV)}$		25	A
正向浪涌电流	I_{FSM}	$t_p=10\text{ms}, T_C=100^{\circ}\text{C}$	300	A
电流时间积分	$I^2 t$	$t_p=10\text{ms}, T_C=100^{\circ}\text{C}$	450	A^2s
工作结温	T_j		-40~150	$^{\circ}\text{C}$

二极管(整流器)电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}	$I_R=0.1\text{mA}$	1600	-	-	V
正向压降	V_F	$I_F=25\text{A}, T_j=25^{\circ}\text{C}$	-	1	-	V
		$T_j=150^{\circ}\text{C}$	-	-	-	
反向漏电流	I_R	$V_R=1600\text{V}, T_j=25^{\circ}\text{C}$	-	-	1	mA
		$T_j=150^{\circ}\text{C}$	-	-	5	
壳到结的热阻	R_{thJC}	每个二极管	-	1.04	-	K/W

IGBT(制动-斩波器)最大额定值 (未特殊说明时, $T_j=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	条件	额定值	单位
集电极-发射极耐压	V_{CES}		1200	V
栅极-发射极耐压	V_{GES}		± 20	V
集电极电流	I_{C}	$T_{\text{C}}=25^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{C}}=100^{\circ}\text{C}$	30 15	A
集电极重复峰值电流	I_{CRM}	$t_{\text{p}}=1\text{ms}$	30	A
耗散功率	P_{D}	$T_{\text{C}}=25^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{vj max}}=150^{\circ}\text{C}$	125	W
短路承受时间	t_{SC}	$T_{\text{j}}=150^{\circ}\text{C}$ $V_{\text{GE}}=15\text{V}$, $V_{\text{CE}}=600\text{V}$	>10	μs
工作结温	T_{j}		$-40\sim 150$	$^{\circ}\text{C}$

IGBT(制动-斩波器)电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态特性						
集电极-发射极击穿	$V_{(\text{BR})\text{CES}}$	$V_{\text{GE}}=0\text{V}$, $I_{\text{C}}=1\text{mA}$	1200	-	-	V
导通压降	$V_{\text{CE(sat)}}$	$V_{\text{GE}}=15\text{V}$, $I_{\text{C}}=15\text{A}$ $T_{\text{j}}=25^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{j}}=150^{\circ}\text{C}$	- -	1.85 2.35	-	
阈值电压	$V_{\text{GE(th)}}$	$I_{\text{C}}=0.6\text{mA}$, $V_{\text{CE}}=V_{\text{GE}}$	4.7	5.8	6.7	
集电极-发射极漏电流	I_{CES}	$V_{\text{CE}}=1200\text{V}$, $V_{\text{GE}}=0\text{V}$	-	-	2.0	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{\text{CE}}=0\text{V}$, $V_{\text{GE}}=20\text{V}$	-	-	500	nA
输入电容	C_{iss}	$V_{\text{CE}}=25\text{V}$	-	1120	-	pF
输出电容	C_{oss}	$V_{\text{GE}}=0\text{V}$	-	91	-	
反馈电容	C_{rss}	$f=1\text{MHz}$	-	51	-	
栅电荷	Q_{G}	$V_{\text{CC}}=900\text{V}$, $I_{\text{C}}=15\text{A}$, $V_{\text{GE}}=15\text{V}$	-	71	-	nC
开关特性 (感性负载)						
开通延迟时间	$t_{\text{d(on)}}$	$T_{\text{j}}=25^{\circ}\text{C}$ $V_{\text{CC}}=600\text{V}$ $I_{\text{C}}=15\text{A}$	-	14	-	ns
上升时间	t_{r}		-	41	-	
关断延迟时间	$t_{\text{d(off)}}$		-	135	-	
下降时间	t_{f}		-	121	-	
开通损耗	E_{on}	$V_{\text{GE}}=\pm 15\text{V}$ $R_{\text{G}}=20\Omega$	-	0.87	-	mJ
关断损耗	E_{off}		-	0.71	-	
开关损耗	E_{ts}		-	1.58	-	

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
开通延迟时间	$t_{d(on)}$	$T_j=150^{\circ}\text{C}$ $V_{CC}=600\text{V}$ $I_C=15\text{A}$	-	13	-	ns
上升时间	t_r		-	41	-	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		-	177	-	
下降时间	t_f		-	183	-	
开通损耗	E_{on}	$V_{GE}=\pm 15\text{V}$ $R_G=20\Omega$	-	0.92	-	mJ
关断损耗	E_{off}		-	1.01	-	
开关损耗	E_{ts}		-	1.93	-	
集电极短路电流	I_{SC}	$V_{GE}=15\text{V}, V_{CC}=600\text{V}$ $T_j=150^{\circ}\text{C}$	-	65	-	A
壳到结的热阻	R_{thJC}	每个IGBT	-	1.0	-	K/W

二极管(制动-斩波器)最大额定值 (未特殊说明时, $T_j=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	条件	额定值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		1200	V
连续正向直流电流	I_F	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	30	A
		$T_C=100^{\circ}\text{C}$	15	
正向重复峰值电流	I_{FRM}	$t_p=1\text{ms}$	30	A
电流时间积分	$I^2 t$	$t_p=10\text{ms}, T_C=100^{\circ}\text{C}$	21	A^2s
工作结温	T_j		-40~150	$^{\circ}\text{C}$

二极管(制动-斩波器)电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
正向压降	V_F	$I_F=15\text{A}$ $T_j=25^{\circ}\text{C}$	-	1.85	-	V
		$T_j=150^{\circ}\text{C}$	-	1.75	-	
反向恢复时间	t_{rr}	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	-	130	-	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$V_R=600\text{V}, I_F=15\text{A}$	-	1.07	-	μC
反向恢复峰值电流	I_{rrm}	$-di/dt=600\text{A}/\mu\text{s}$	-	18.0	-	A
反向恢复时间	t_{rr}	$T_j=150^{\circ}\text{C}$	-	210	-	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}	$V_R=600\text{V}, I_F=15\text{A}$	-	2.15	-	μC
反向恢复峰值电流	I_{rrm}	$-di/dt=600\text{A}/\mu\text{s}$	-	22.0	-	A
壳到结的热阻	R_{thJCD}	每个二极管	-	1.6	-	K/W

负温度系数热敏电阻

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
额定电阻值	R_{25}	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	-	5	-	K Ω
R100偏差	$\Delta R/R$	$T_C=25^{\circ}\text{C}, R_{100}=481\Omega$	tbd	-	tbd	%
耗散功率	P_{25}	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	-	tbd	-	mW
B-值	$B_{25/50}$	$R_2=R_{25}\exp[B_{25/50}(1/T_2-1/(298.15\text{K}))]$	-	3380	-	K
B-值	$B_{25/80}$	$R_2=R_{25}\exp[B_{25/80}(1/T_2-1/(298.15\text{K}))]$	-	3440	-	K

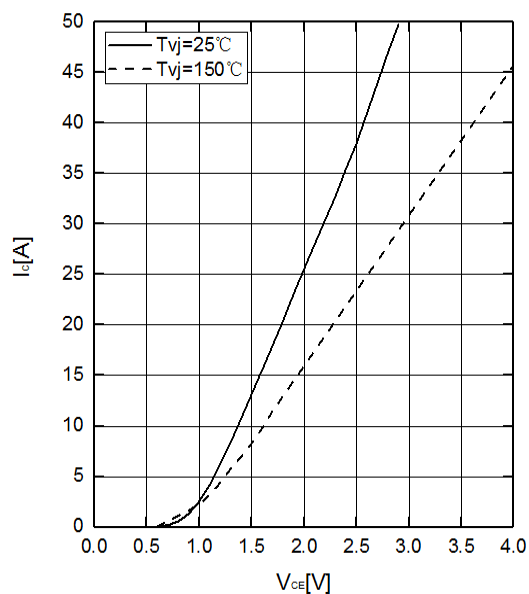
模块

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
绝缘测试电压	V_{ISOL}	$f = 50\text{Hz}, 1\text{minute}$	2500	-	-	V
最大结温	$T_{vj\text{ max}}$		-	-	150	$^{\circ}\text{C}$
工作结温	T_j		-40	-	150	$^{\circ}\text{C}$
外壳－散热器热阻	$R_{\theta\text{CS}}$	每个模块	-	0.03	-	K/W
储存温度	T_{stg}		-40	-	125	$^{\circ}\text{C}$
模块安装扭距	M	Mounting Screw:M5	3.0	-	6.0	N·m
重量	G		-	180	-	g

输出特性 IGBT, 逆变器 (典型)

output characteristic IGBT, Inverter (typical)

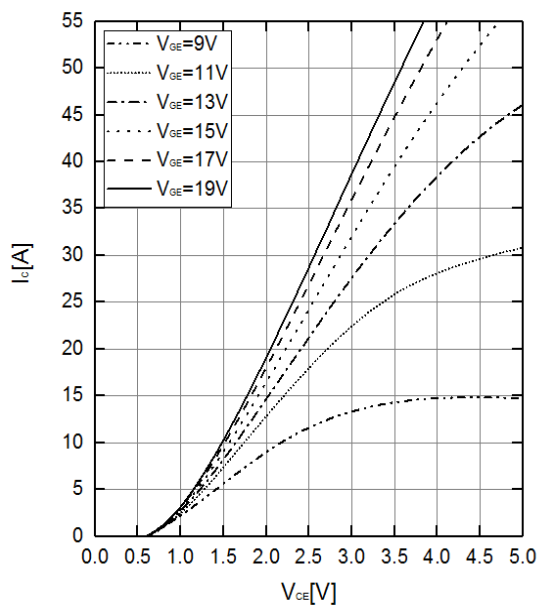
$I_C = f(V_{CE})$, $V_{GE} = 15\text{ V}$



输出特性 IGBT, 逆变器 (典型)

output characteristic IGBT, Inverter (typical)

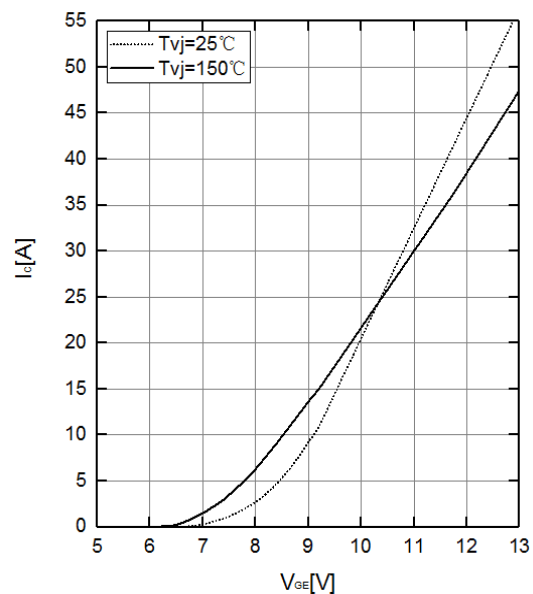
$I_C = f(V_{CE})$, $T_j = 150^\circ\text{C}$



传输特性 IGBT, 逆变器 (典型)

transfer characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_C = f(V_{GE})$, $V_{CE} = 20\text{ V}$

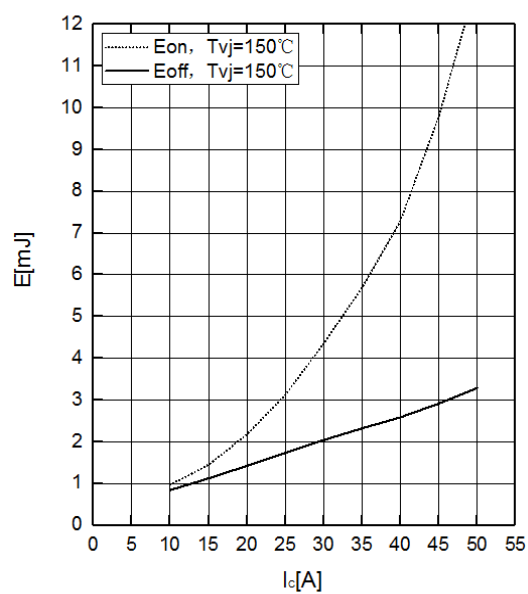


开关损耗 IGBT, 逆变器 (典型)

switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$

$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 47\ \Omega$, $R_{Goff} = 47\ \Omega$, $V_{CE} = 600\text{ V}$

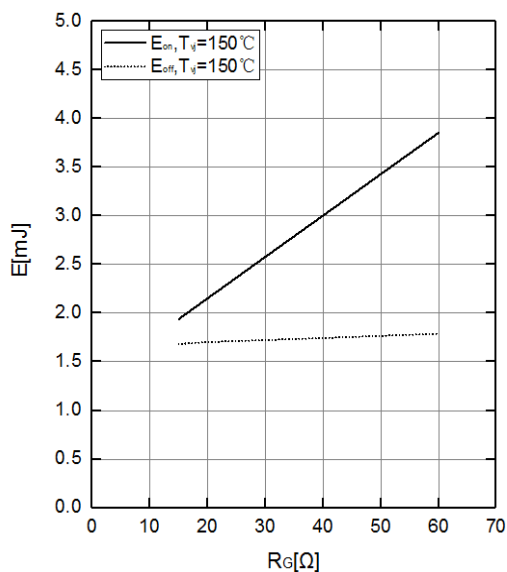


开关损耗 IGBT, 逆变器 (典型)

switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$

$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_C = 25\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$

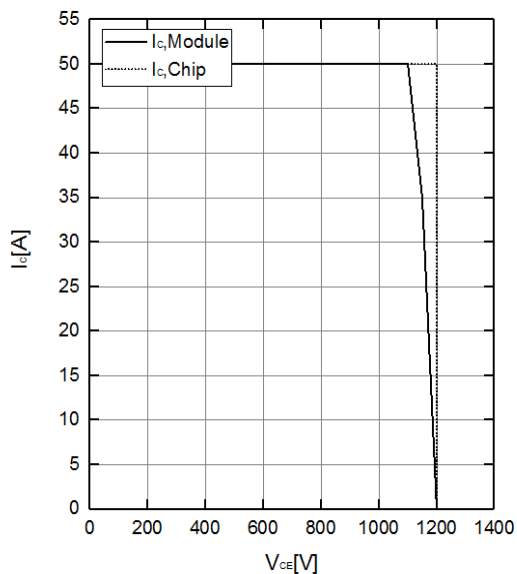


反偏安全工作区 IGBT, 逆变器 (RBSOA)

reverse bias safe operating area IGBT, Inverter

$I_C = f(V_{CE})$

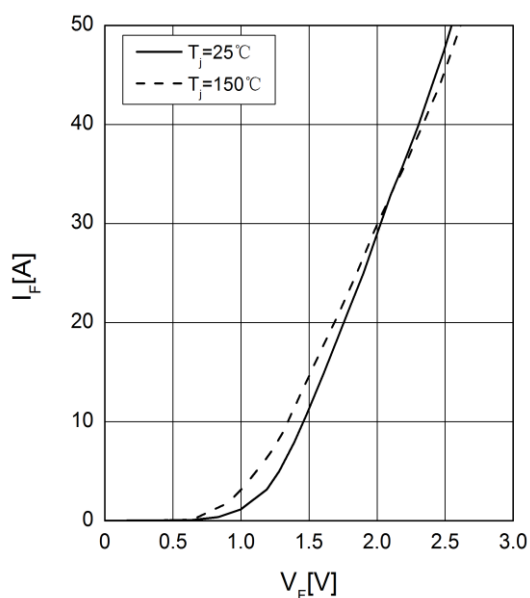
$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 47\text{ Ω}$, $T_j = 150^\circ\text{C}$



正向偏压特性 二极管, 逆变器 (典型)

forward characteristic of Diode, Inverter (typical)

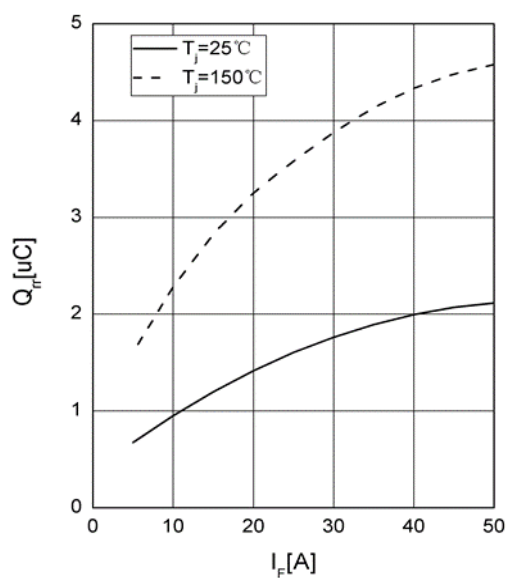
$I_F = f(V_F)$



恢复电荷 二极管, 逆变器 (典型)

recovered charge of Diode, Inverter (typical)

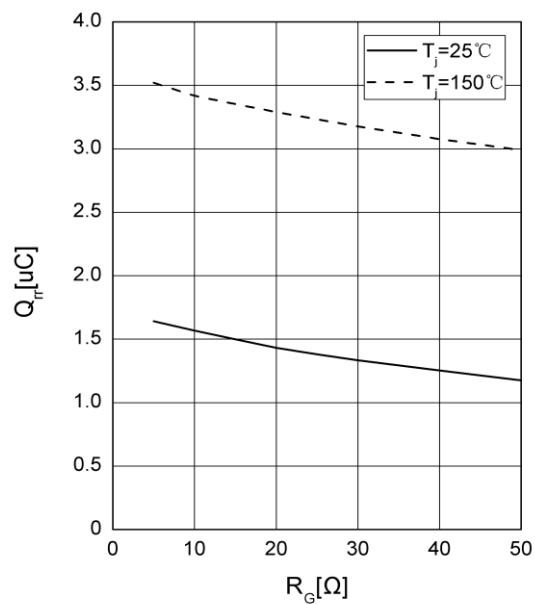
$Q_{rr} = f(I_F)$



恢复电荷 二极管,逆变器 (典型)

recovered charge of Diode, Inverter (typical)

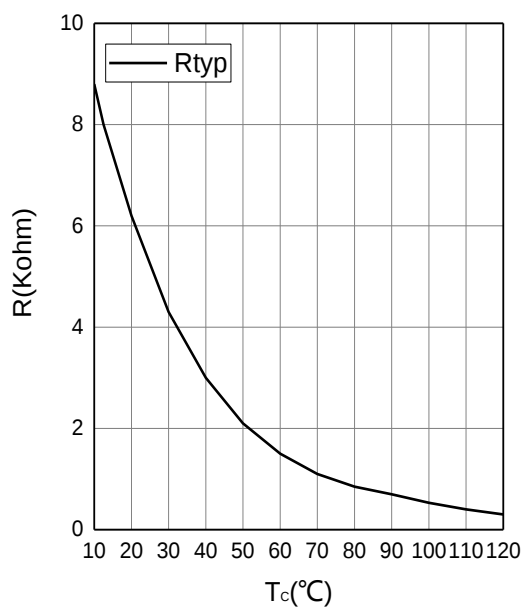
$Q_{rr} = f(R_G)$, $I_F = 25A$, $V_{CE} = 600V$



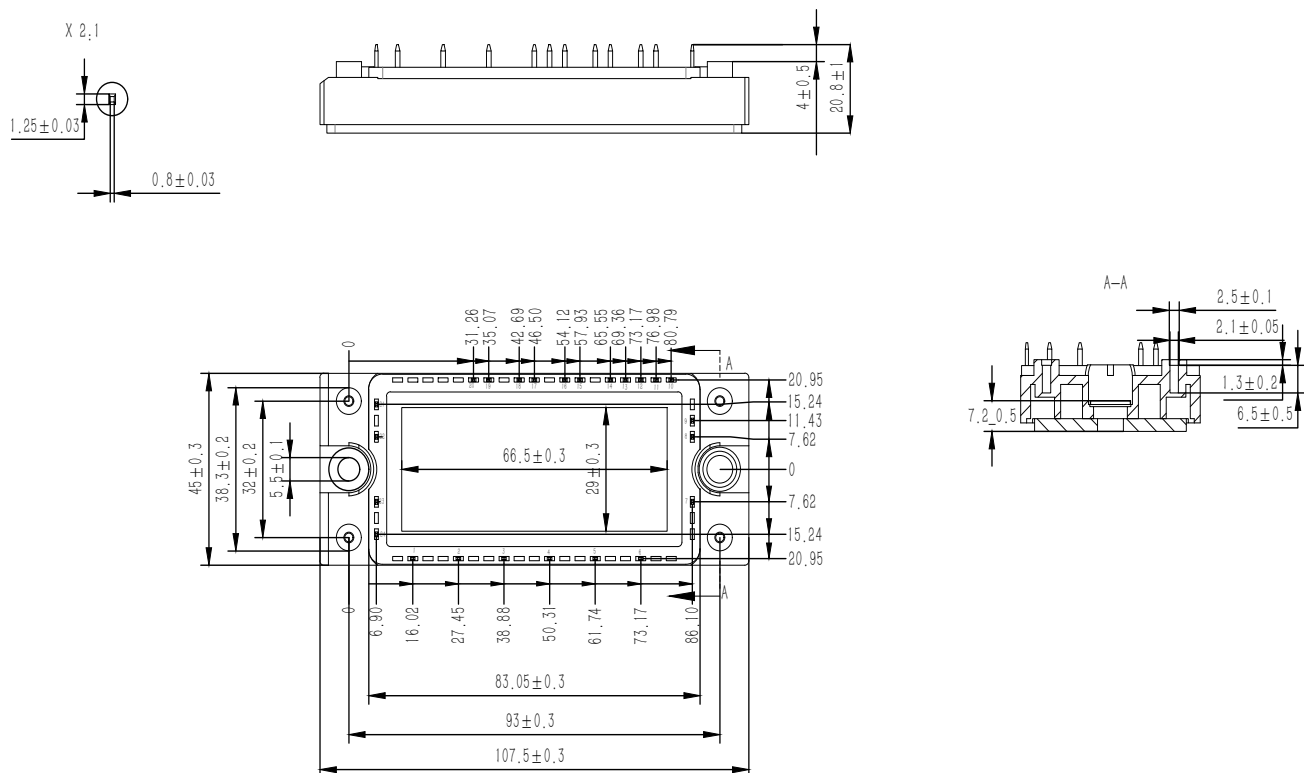
负温度系数热敏电阻 温度特性

NTC temperature characteristic (typical)

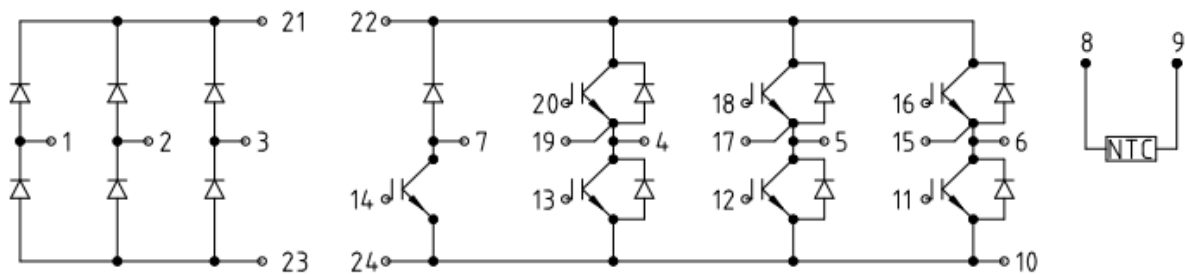
$R = f(T)$



模块尺寸 (单位: mm)



电路示意图



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [IGBT Transistors](#) category:

Click to view products by [JUNSHINE](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[748152A](#) [FGH60T65SHD_F155](#) [APT100GT60B2RG](#) [APT13GP120BG](#) [APT20GN60BG](#) [APT20GT60BRDQ1G](#) [APT25GN120B2DQ2G](#)
[APT35GA90BD15](#) [APT36GA60BD15](#) [APT40GP60B2DQ2G](#) [APT40GP90B2DQ2G](#) [APT50GN120B2G](#) [APT50GT60BRG](#)
[APT64GA90B2D30](#) [APT70GR120J](#) [NGTB10N60FG](#) [NGTB30N60L2WG](#) [NGTG25N120FL2WG](#) [IGP30N60H3XKSA1](#) [STGB15H60DF](#)
[STGFW20V60DF](#) [STGFW30V60DF](#) [STGFW40V60F](#) [STGWA25H120DF2](#) [FGB3236_F085](#) [APT25GN120BG](#) [APT25GR120S](#)
[APT30GN60BDQ2G](#) [APT30GN60BG](#) [APT30GP60BG](#) [APT30GS60BRDQ2G](#) [APT30N60BC6](#) [APT35GP120JDQ2](#) [APT36GA60B](#)
[APT45GR65B2DU30](#) [APT50GP60B2DQ2G](#) [APT68GA60B](#) [APT70GR65B](#) [APT70GR65B2SCD30](#) [GT50JR22\(STA1ES\)](#) [TIG058E8-TL-H](#)
[IDW40E65D2](#) [SGB15N120ATMA1](#) [NGTB50N60L2WG](#) [STGB10H60DF](#) [STGB20V60F](#) [STGB40V60F](#) [STGFW80V60F](#)
[IGW40N120H3FKSA1](#) [RJH60D7BDPQ-E0#T2](#)